

### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1200, 1400 1600, 1800	V V
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{DSM}}$	1200, 1400 1600, 1800	V V
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{RSM}}$	1300, 1500 1700, 1900	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert (pro Element) RMS on-state current (per chip)		$I_{\text{TRMSM}}$	100	A
Effektivstrom (pro Phase) RMS current (per arm)	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}} = 73^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{A}} = 45^{\circ}\text{C}, \text{KM 11}$ $T_{\text{A}} = 45^{\circ}\text{C}, \text{KM 33}$ $T_{\text{A}} = 35^{\circ}\text{C}, \text{KM 14 } (V_L = 45/\text{s})$ $T_{\text{A}} = 35^{\circ}\text{C}, \text{KM 33 } (V_L = 90/\text{s})$	$I_{\text{RMS}}$	115 141 38 55 97 115	A A A A A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	$I_{\text{TSM}}$	1000 870	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	$I^2t$	5000 3780	A <sup>2</sup> s A <sup>2</sup> s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{\text{GM}} = 0,6\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{\text{cr}}$	120	A/ $\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 8. Kennbuchstabe / 8th letter F	$(dv/dt)_{\text{cr}}$	1000	V/ $\mu\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, I_{\text{T}} = 150\text{A}$	$V_{\text{T}}$	max. 1,81	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$V_{(\text{T0})}$	0,95	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$r_{\text{T}}$	4,3	m $\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}$	$I_{\text{GT}}$	max. 150	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}$	$V_{\text{GT}}$	max. 2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_{\text{D}} = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$I_{\text{GD}}$	max. 5,0 max. 2,5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$V_{\text{GD}}$	max. 0,2	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{A}} = 5\Omega$	$I_{\text{H}}$	max. 200	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{GK}} \geq 20\Omega$ $i_{\text{GM}} = 0,6\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}, t_{\text{G}} = 10\mu\text{s}$	$I_{\text{L}}$	max. 600	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $V_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max. 10	mA
Zündverzögerung gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 0,6\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$t_{\text{gd}}$	max. 1,2	$\mu\text{s}$

# Technische Information / Technical Information

**eupec**

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

**TT W3C 115 N 12...18 (ISOPACK)**



## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vjmax}$ $i_{TM} = 50A$ $V_{RM} = 100V$ , $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dV_{D}/dt = 20V/\mu s$ , $-di_T/dt = 10A/\mu s$ 7. Kennbuchstabe / 7th letter O	$t_q$	typ.	190	$\mu s$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50Hz$ , $t = 1min$ RMS, $f = 50Hz$ , $t = 1sec$	$V_{ISOL}$		3,0 3,6	kV kV

## Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per module, $\Theta = 180^\circ sin$ pro Element / per chip, $\Theta = 180^\circ sin$ pro Modul / per module, DC pro Element / per chip, DC	$R_{thJC}$	max.	0,083 0,500 0,078 0,470	$^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module pro Element / per chip	$R_{thCK}$	max.	0,033 0,200	$^\circ C/W$ $^\circ C/W$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vjmax}$		125	$^\circ C$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c,op}$		- 40...+125	$^\circ C$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$		- 40...+130	$^\circ C$

## Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

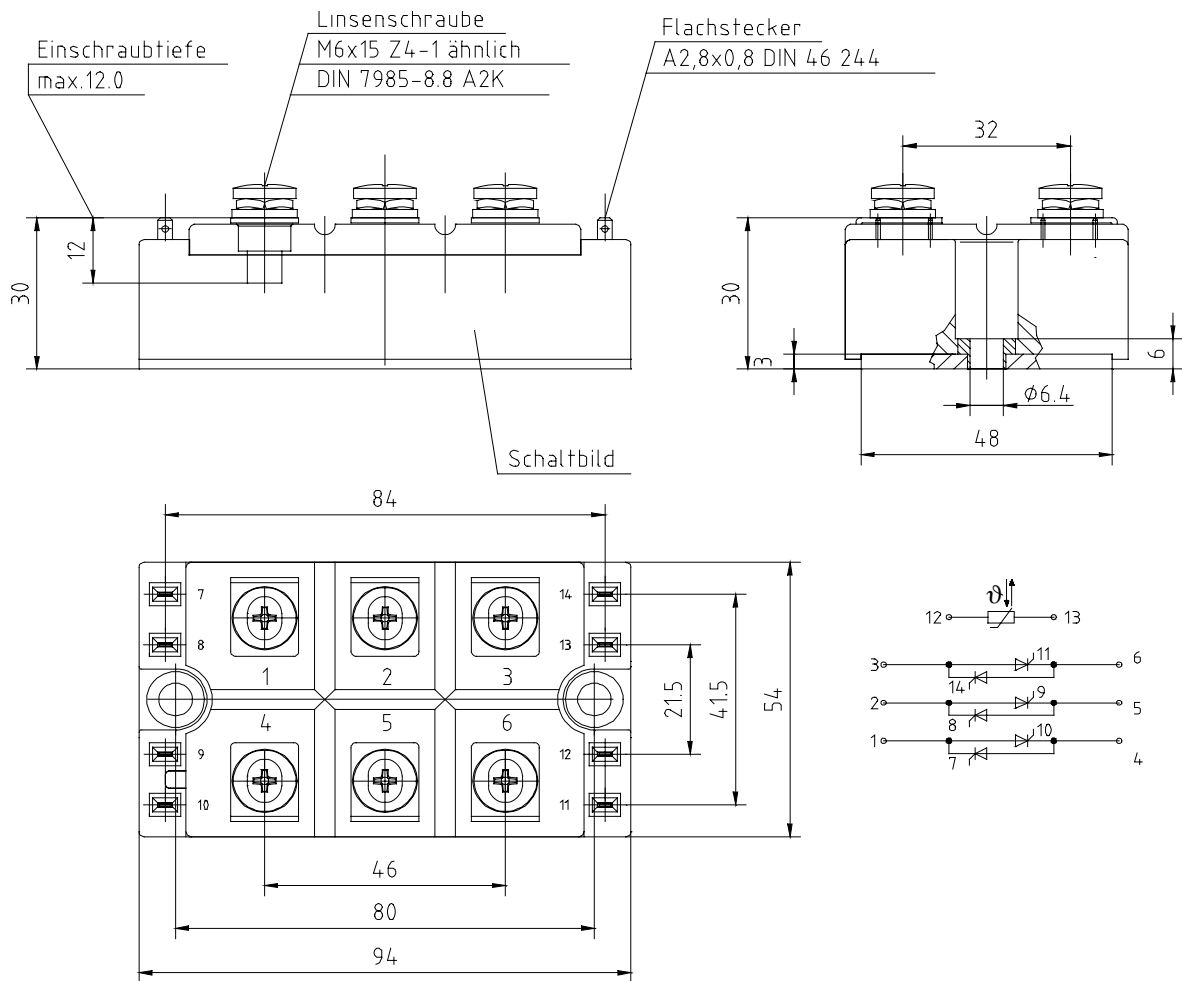
Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix				Seite 3 page 3	
Si-Elemente mit Lötkontakt, glaspassiviert Si-pellets with soldered contact, glass-passivated					
Innere Isolation internal insulation				$Al_2O_3$	
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque	Toleranz / tolerance $\pm 15\%$	M1		6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / tolerance $+5\% / -10\%$	M2		6	Nm
Gewicht weight		G	typ.	300	g
Kriechstrecke creepage distance				12,5	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50Hz$			50	$m/s^2$

## Temperatursensor / Temperature sensor

Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ C$ $R_{100} = 493\Omega \pm 5\%$	$R_{25}$		5	$k\Omega$
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ C$	$P_{25}$	max.	20	mW

### Kühlkörper / heatsinks : KM 11; KM 14; KM 17; KM 33

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

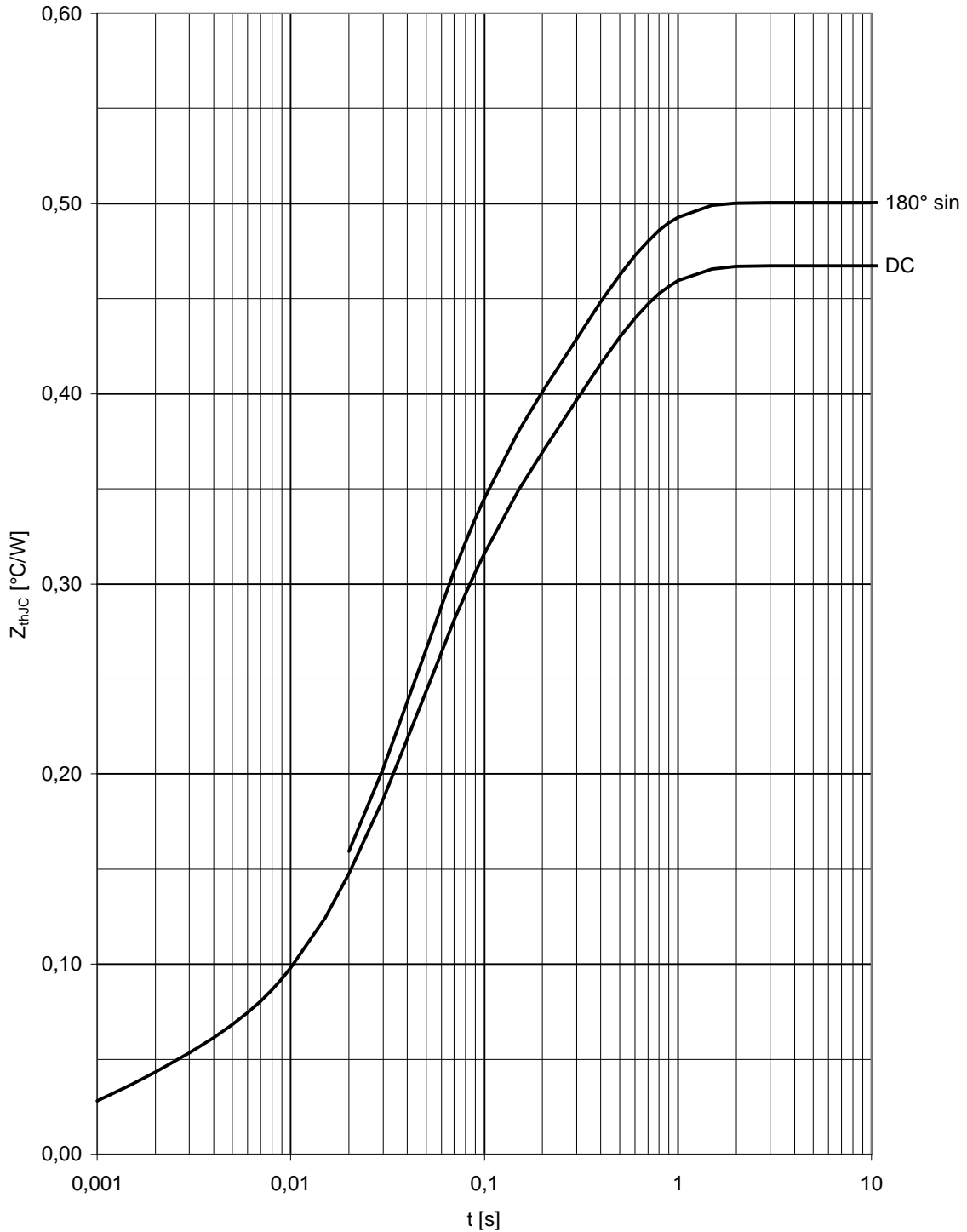


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  für DC

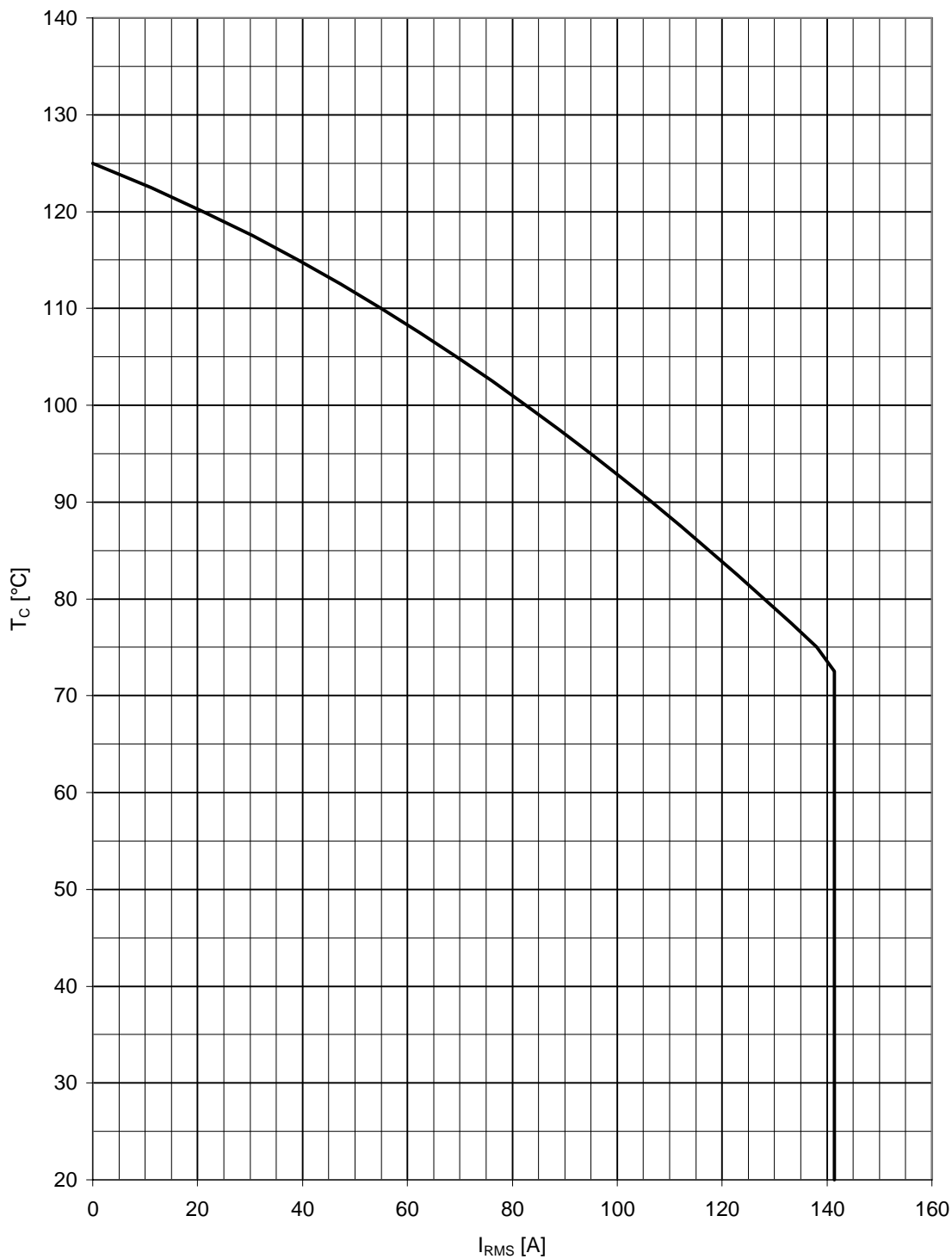
Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}C / W]$	0,18100	0,25100	0,03520				
$\tau_n [s]$	0,31800	0,03870	0,00109				

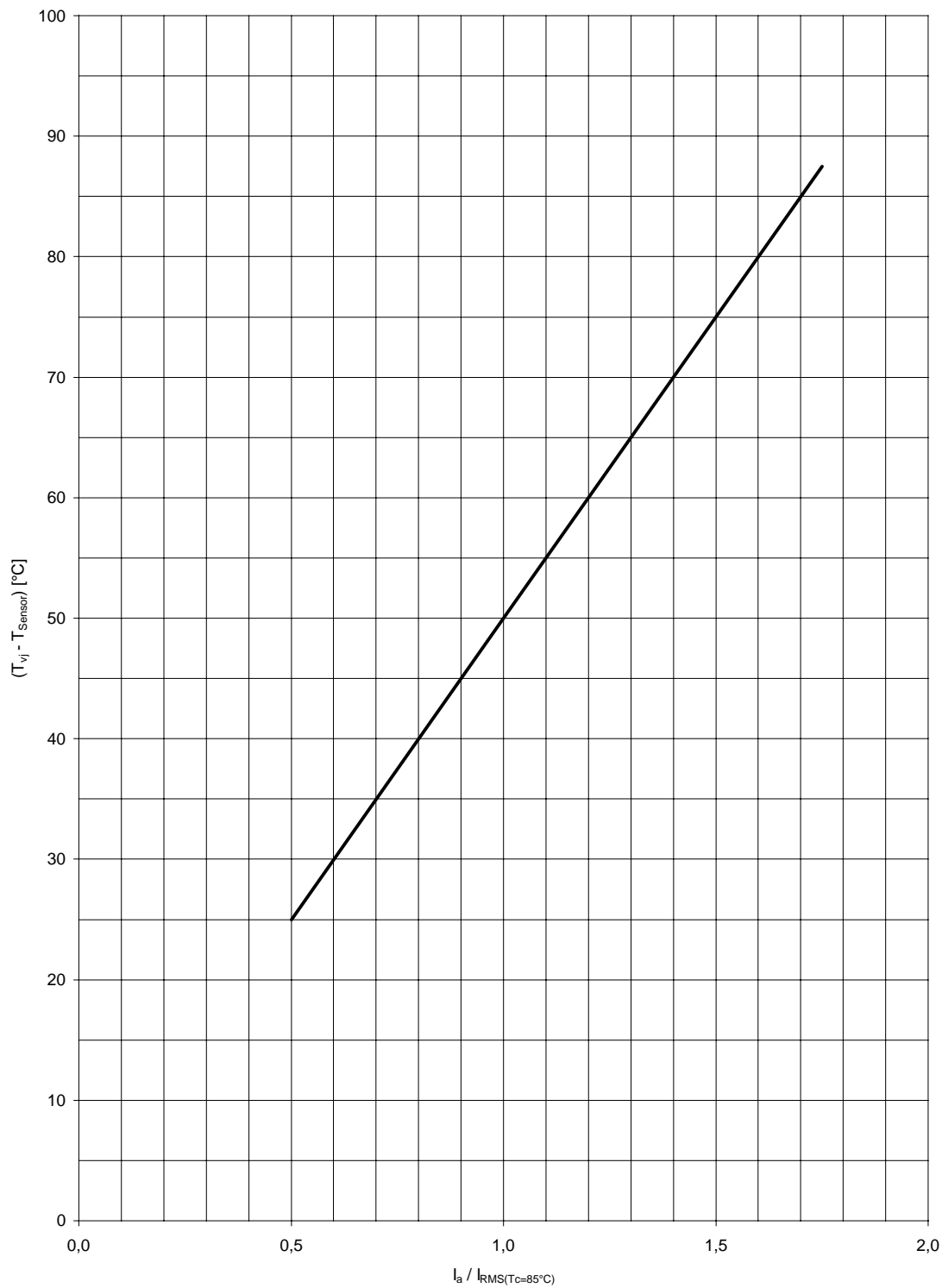
Analytische Funktion: 
$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$



Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm,  $Z_{th(jc)} = f(t)$   
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\alpha$



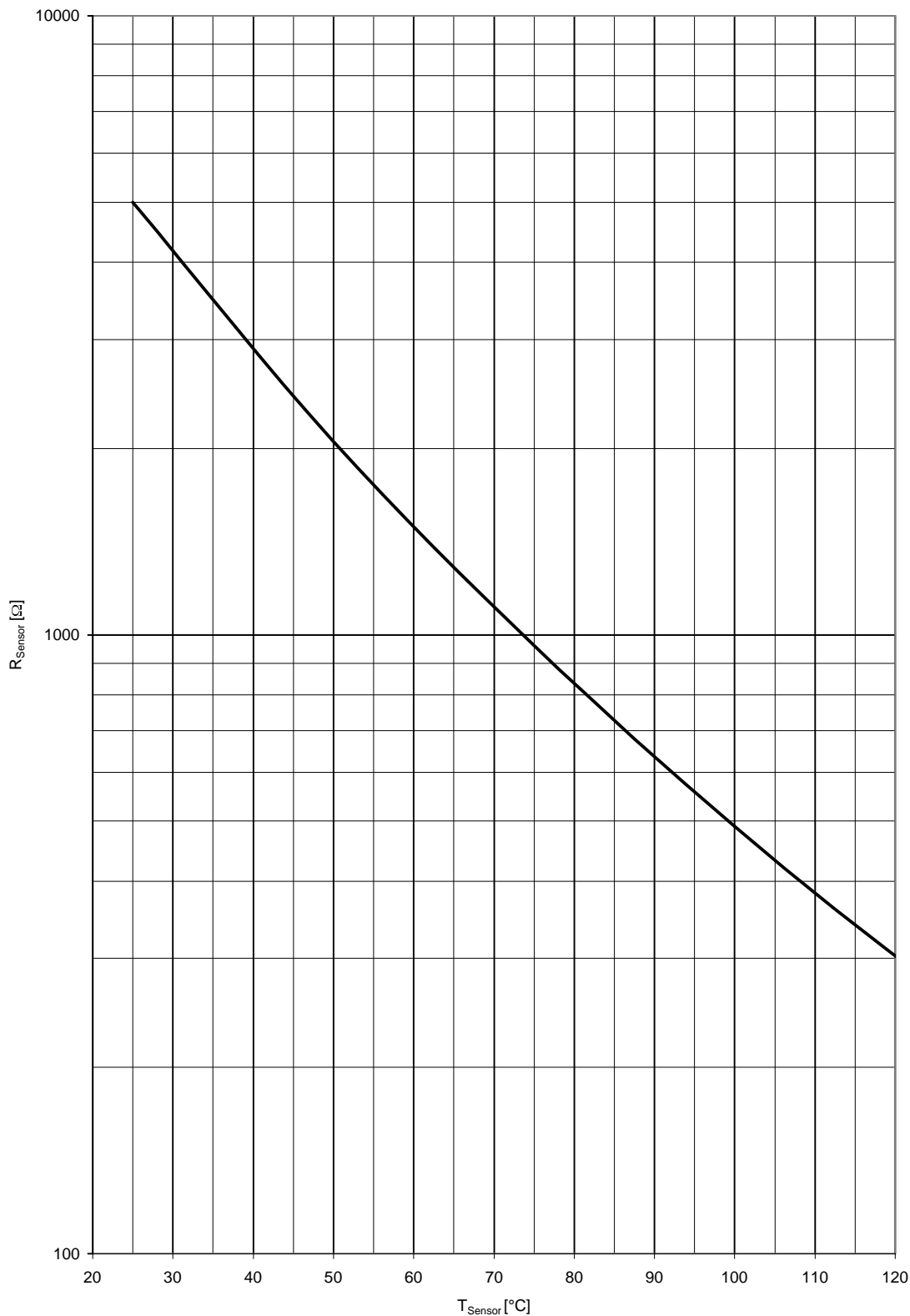
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_c = f(I_{RMS})$



Differenz zwischen Sperrschicht- und Sensortemperatur / Difference between the values of junction and sensor temperature  $(T_j - T_{Sensor}) = f(I_a / I_{RMS(T_c=85^\circ C)})$

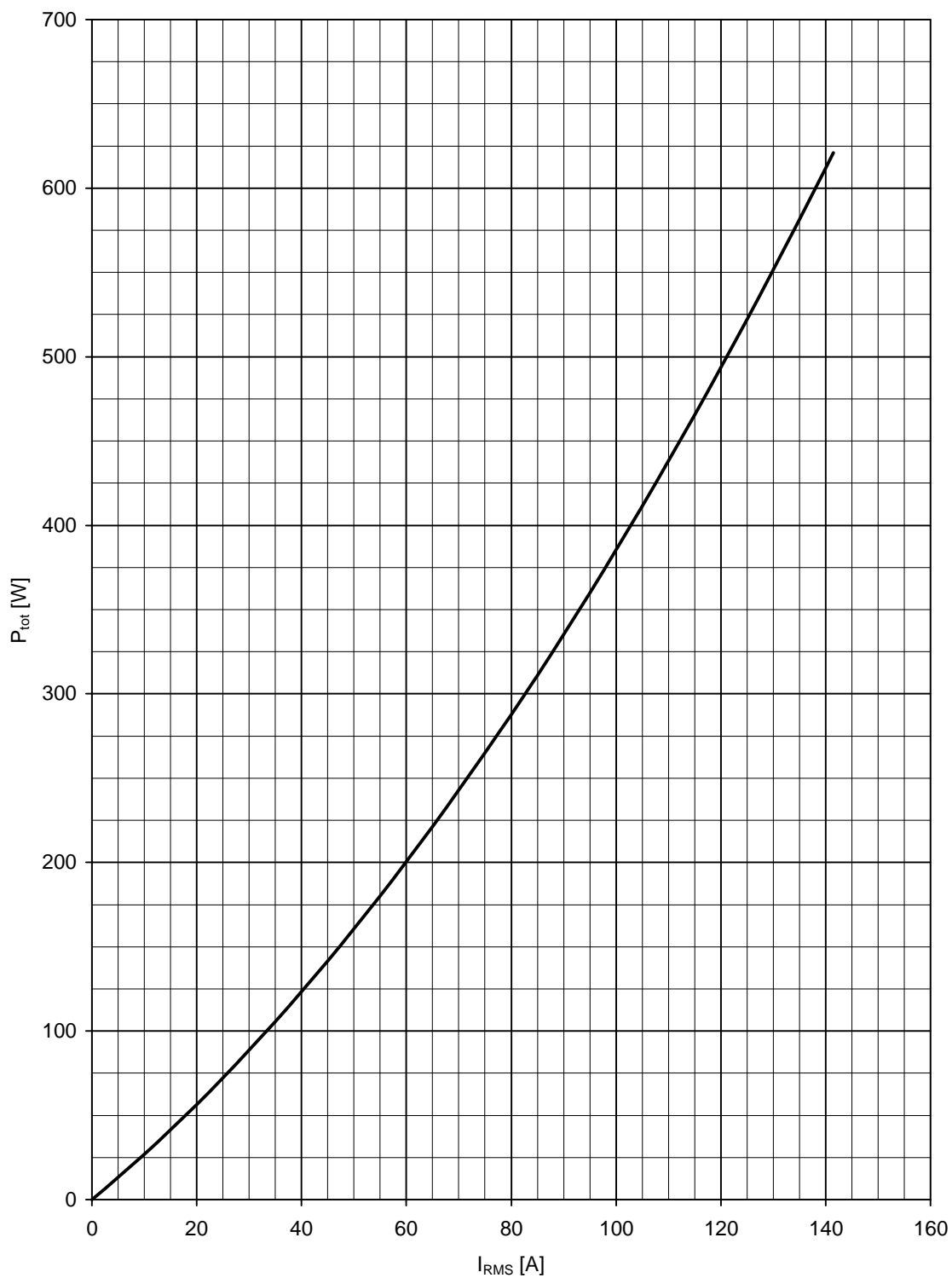
$I_a$ : Anlaufstrom / Starting current

$I_{RMS}$ : Effektivstrom (pro Phase) / RMS current (per arm)



Sensorwiderstand / Sensor resistance  $R_{Sensor} = f(T_{Sensor})$





Gesamtverlustleistung pro Modul / Total power dissipation per module  $P_{tot} = f(I_{RMS})$   
 $I_{RMS}$ : Effektivstrom (pro Phase) / RMS current (per arm)